

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第3区分

【発行日】平成20年5月29日(2008.5.29)

【公表番号】特表2008-503179(P2008-503179A)

【公表日】平成20年1月31日(2008.1.31)

【年通号数】公開・登録公報2008-004

【出願番号】特願2007-527231(P2007-527231)

【国際特許分類】

H 01 P 1/397 (2006.01)

H 01 P 5/18 (2006.01)

【F I】

H 01 P 1/397

H 01 P 5/18 G

【手続補正書】

【提出日】平成20年4月11日(2008.4.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1の結合器(10)と、

平面を規定している第1及び第2の伝送ライン(8、9)によって前記第1の結合器と結合されている第2の結合器(20)と、

第1の伝送ライン(8)を横切って形成され、前記平面と実質的に平行であり、その平面内にある第1の磁界(28)と、

第2の伝送ライン(9)を横切って形成され、前記平面と実質的に平行であり、その平面内にある第2の磁界(29)とを具備しているサークュレータ(5)。

【請求項2】

第1の磁界(28)は、実質的に第1の伝送ライン(8)と直交し、第2の磁界(29)は、実質的に第2の伝送ライン(9)と直交している請求項1記載のサークュレータ(5)。

【請求項3】

第1及び第2の結合器(10、20)はランゲ結合器である請求項1記載のサークュレータ(5)。

【請求項4】

第1及び第2の結合器(10、20)は基板の表面上に形成されている請求項1記載のサークュレータ(5)。

【請求項5】

誘電体基板(7)と、

基板(7)上に形成され、第1の入力ポート(11)と、第1の出力ポート(12)と、第1及び第2の結合されたポート(13、14)とを有する第1のインターデジタルの4ポートマイクロストリップ結合器(10)と、

基板(7)上に形成され、第2の入力ポート(21)と、第2の出力ポート(22)と、第3及び第4の結合されたポート(24、23)とを有する第2のインターデジタルの4ポートマイクロストリップ結合器(20)と、

第1の結合されたポート(13)と第3の結合されたポート(24)との間に接続されたフェライトで負荷された第1の伝送ライン(8)と、

第2の結合されたポート(14)と第4の結合されたポート(23)との間に接続されたフェライトで負荷された第2の伝送ライン(9)と、

基板(7)に取付けられた第1及び第2の磁石(18、19)とを具備し、

前記第1の磁石(18)は第1の伝送ライン(8)と交差している第1の磁界(28)を形成し、それは実質的に基板(7)と平行であり、第2の磁石(19)は第2の伝送ライン(9)と交差して第1の磁界の極性と反対の極性である第2の磁界(29)を形成し、それは実質的に基板(7)と平行である低プロファイル構造を有するセキュレータ(5)。